

# FR40B05 thru FR40JR05

## Silicon Fast Recovery Diode

 $V_{RRM} = 100 \text{ V} - 600 \text{ V}$   $I_F = 40 \text{ A}$ 

DO-5 Package

#### **Features**

- High Surge Capability
- $\bullet$  Types from 100 V to 600 V  $V_{\text{RRM}}$
- Not ESD Sensitive

#### Note:

- 1. Standard polarity: Stud is cathode.
- 2. Reverse polarity (R): Stud is anode.
- 3. Stud is base.







## Maximum ratings, at $T_j = 25$ °C, unless otherwise specified ("R" devices have leads reversed)

Parameter	Symbol	Conditions	FR40B(R)05	FR40D(R)05	FR40G(R)05	FR40J(R)05	Unit
Repetitive peak reverse voltage	$V_{RRM}$		100	200	400	600	V
RMS reverse voltage	$V_{RMS}$		70	140	280	420	V
DC blocking voltage	$V_{DC}$		100	200	400	600	V
Continuous forward curre	ent I <sub>F</sub>	T <sub>C</sub> ≤ 100 °C	40	40	40	40	Α
Surge non-repetitive forv current, Half Sine Wave	vard I <sub>F,SM</sub> -	$T_C = 25  ^{\circ}\text{C},  t_p = 8.3  \text{ms}$	500	500	500	500	А
Operating temperature	Tj		-55 to 150	-55 to 150	-55 to 150	-55 to 150	°C
Storage temperature	T <sub>stg</sub>		-55 to 150	-55 to 150	-55 to 150	-55 to 150	°C

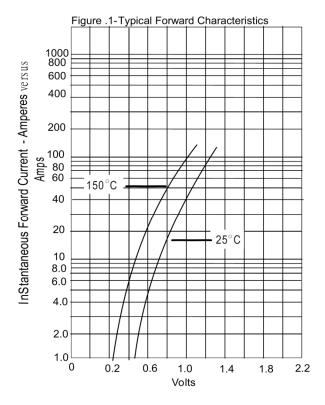
### Electrical characteristics, at Tj = 25 °C, unless otherwise specified

Parameter	Symbol	Conditions	FR40B(R)05	FR40D(R)05	FR40G(R)05	FR40J(R)05	Unit
Diode forward voltage	V <sub>F</sub>	I <sub>F</sub> = 40 A, T <sub>j</sub> = 25 °C	1.0	1.0	1.0	1.0	V
Reverse current	I <sub>R</sub>	$V_R = 100 \text{ V}, T_j = 25 ^{\circ}\text{C}$	25	25	25	25	μA
Reverse current		$V_R = 100 \text{ V}, T_j = 125 ^{\circ}\text{C}$	10	10	10	10	mA
Recovery Time							
Maximum reverse recovery time	T <sub>RR</sub>	I <sub>F</sub> =0.5 A, I <sub>R</sub> =1.0 A, I <sub>RR</sub> = 0.25 A	500	500	500	500	nS
Thermal characteristics							
Thermal resistance, junction - case	$R_{\text{thJC}}$		0.8	0.8	0.8	0.8	°C/W

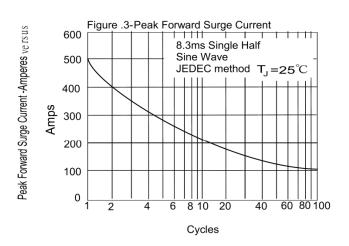




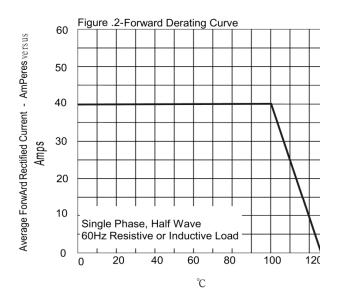
## FR40B05 thru FR40JR05



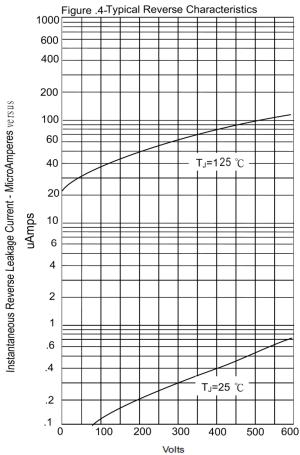
Instantaneous Forward Voltage - Volts



Number Of Cycles At 60Hz - Cycles



Case Temperature - °C

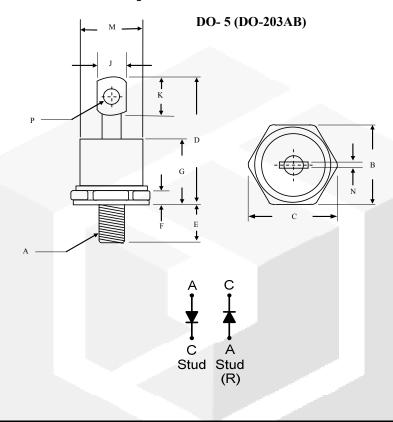


Percent Of Rated Peak Reverse Voltage - Volts



## Package dimensions and terminal configuration

Product is marked with part number and terminal configuration.



	Inc	hes	Millimeters		
	Min	Max	Min	Max	
A		1/4 -2	8 UNF		
В	0.669	0.687	17.19	17.44	
С		0.794		20.16	
D		1.020		25.91	
Е	0.422	0.453	10.72	11.50	
F	0.115	0.200	2.93	5.08	
G		0.460		11.68	
J		0.280		7.00	
K	0.236		6.00		
M		0.589		14.96	
N		0.063		1.60	
P	0.140	0.175	3.56	4.45	

## **ПОСТАВКА** ЭЛЕКТРОННЫХ КОМПОНЕНТОВ

Общество с ограниченной ответственностью «МосЧип» ИНН 7719860671 / КПП 771901001 Адрес: 105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107

# Данный компонент на территории Российской Федерации Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

## http://moschip.ru/get-element

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

#### Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г. Москва, ул. Щербаковская д. 3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru moschip.ru\_6 moschip.ru\_4 moschip.ru\_9